



109 年度工研院 廢氣處理、儲能/節能材料及其他應用等專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人(以下簡稱「國內廠商」)。

三、讓與標的：本讓與案包含廢氣處理、儲能/節能材料及其他應用等專利共 45 案 101 件（以下簡稱「讓與標的」）。「讓與標的」中之第 1 案係與第三人共有(以下簡稱「共有專利」)，「共有專利」僅讓售 50%工研院應有部分之專利。「讓與標的」相關資訊詳如附件。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）110 年 1 月 14 日 14 時整於工研院中興院區 51 館 110-1 室舉辦。

2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 110 年 1 月 13 日 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「廢氣處理、儲能/節能材料及其他應用等專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 110 年 1 月 13 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

3. 自本標案公告日起至截標日 110 年 1 月 25 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表（以下統稱「投標文件」），裝入信封密封之，並在信封上註明「廢氣處理、儲能/節能材料及其他應



用等專利讓與案投標」，於截標日 110 年 1 月 25 日 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 李小姐收

2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

八、決標方法：

1. 開標日為 110 年 1 月 26 日。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家(含)以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，該第三人以「國內廠商」且有參與投標者為優先。

九、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 20 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，該第三人以「國內廠商」且有參與投標者為優先。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，該第三人以「國內廠商」且有參與投標者為優先。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」自雙方依法簽章並經經濟部及「讓與標的」共有人同意後生效。得標廠商充分了解工研院對於經濟部及共有人之意見並無影響力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：(1)工研院已與第三人簽訂之授權契約中關於工研院之義務；(2)工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及(3)工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，應依政府相關法令規定及「讓與契約書」約定，取得主管機關(包含但不限於經濟部技術處，以下同)核准及/或工研院同意後始得為之，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專

利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，為一切必要之申請，且得標廠商應於取得主管機關核准及/或工研院同意後，始得為下述行為：
 - (1) 得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；
 - (2) 得標廠商非專屬授權運用之對象為非我國研究機構或企業，或非專屬授權運用之區域為我國管轄區域外；
 - (3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
 - (4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。
13. 得標廠商為前述申請時，應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，並應配合工研院向主管機關為一切必要之申請及提供一切相關之文件。
14. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

- (1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。
 - (2) 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。
 - (3) 為增進國家重大利益者。
15. 得標廠商並同意，若違反「九、契約事項：」之第 4、8、9、12、13、14、15 及 16 項等約定者，工研院得逕行將「讓與標的」過去、現在及未來之權利，非專屬授權予第三人，並保有相關之收益。若有第 13 項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，且經濟部及工研院無須負擔損害賠償責任。
 16. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及/或工研院同意並將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。
 17. 得標廠商應使所有「後手」遵守「九、契約事項：」之第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 17 項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。
 18. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院，並取得工研院書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。
 19. 得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（下稱：股權變動）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於股權變動情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該股權變動情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」或以書面另議新約。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十二、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十一、注意事項：



本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 李小姐

電話：+886 591-7759，傳真：+886 582-0466

電子信箱：lislee@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：專利清單

分類	案號	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	公告號	專利起期	專利迄期	委辦單位	備註
廢氣處理	1	P02940040TW	高活性化學濾材、其製備方法及其吸附去除有害氣體之用途	TW	獲證	94145309	I314473	20090911	20251219	工研院	共有
	2	P54960008CN	含氟化合物氣體之處理方法	CN	獲證	200710187190.2	I01450273	20120815	20271127	工研院	
		P54960008TWC1	含氟化合物氣體之處理方法	TW	獲證	96137233	I352616	20111121	20271003	工研院	
3	P54960052TW	廢氣處理裝置和處理廢氣之方法	TW	獲證	96143002	I359692	20120311	20271113	工研院		
儲能電池	4	P27990012CN	多層結構納米二氧化鈦光電極及其製造方法	CN	獲證	201010267081.3	I02385997	20140723	20300826	經濟部技術處	
		P27990012TW	多層結構奈米二氧化鈦光電極及其製造方法	TW	獲證	99125384	I419392	20131211	20300729	經濟部技術處	
	5	P54000042CN	光學鈍化薄膜及其製造方法以及太陽能電池	CN	獲證	201110432484.3	I03123938	20150902	20311220	經濟部技術處	
		P54000042TW	光學鈍化薄膜及其製造方法以及太陽能電池	TW	獲證	100142252	I448431	20140811	20311117	經濟部技術處	
	6	P54000128CN	形成圖案化摻雜區的方法	CN	獲證	201210411354.6	I03681948	20160525	20321024	經濟部技術處	
		P54000128DE	一種擴散圖形化之製作方法	DE	獲證	EP13162155.9	EP2713384	20170517	20330402	經濟部技術處	
		P54000128TW	形成圖案化摻雜區的方法	TW	獲證	101135229	I501292	20150921	20320925	經濟部技術處	
		P54000128TWD1	形成圖案化摻雜區的方法	TW	獲證	104119222	I528420	20160401	20320925	經濟部技術處	
		P54000128US	形成圖案化摻雜區的方法	US	獲證	13/710,795	9,012,314	20150421	20330506	經濟部技術處	
		P54000128USD1	形成圖案化摻雜區的方法	US	獲證	14/626,675	9,040,401	20150526	20321210	經濟部技術處	
	7	P54980019TW	太陽能電池裝置及其製造方法	TW	獲證	98115795	I381537	20130101	20290512	經濟部技術處	
	8	P54980030CN	太陽能電池裝置	CN	獲證	201010532195.6	I02468347	20140326	20301101	經濟部技術處	
		P54980030TWC1	太陽能電池裝置	TW	獲證	99135177	I440193	20140601	20301014	經濟部技術處	
		P54980030US	太陽能電池裝置及其製造方法	US	獲證	12/754,544	8,558,106	20131015	20310429	經濟部技術處	



	P549800 30USC1	太陽能電池裝置	US	獲證	12/908,701	8,563,853	20131022	20301015	經濟部技術處	
9	P549900 27CN	半導體組件的鈍化層結構及其形成方法	CN	獲證	201010555848.2	102468244	20150930	20301117	工研院	曾授權
	P549900 27DE	結晶矽太陽能電池的表面鈍化之方法	DE	獲證	EP11003196.0	EP2448002	20160511	20310414	工研院	
	P549900 27ES	結晶矽太陽能電池的表面鈍化之方法	ES	獲證	EP11003196.0	EP2448002	20160511	20310414	工研院	
	P549900 27TW	半導體元件的鈍化層結構及其形成方法	TW	獲證	99137154	I424578	20140121	20301028	工研院	曾授權
	P549900 27US	半導體元件的鈍化層結構及其形成方法	US	獲證	13/084,486	8,564,104	20131022	20310410	工研院	曾授權
	P549900 27USC1	半導體元件的鈍化層結構及其形成方法	US	獲證	14/058,403	9,040,983	20150526	20310410	工研院	
10	P059200 43TW	電化學電池特性之量測裝置與方法	TW	獲證	92132686	I237696	20050811	20231120	經濟部技術處	曾授權
11	P279601 08CN	雙極板與燃料電池	CN	獲證	200810125928.7	101604756	20110518	20280610	經濟部技術處	
	P279601 08TW	雙極板與燃料電池	TW	獲證	97119123	I445238	20140711	20280522	經濟部技術處	
12	P279701 18TW	燃料電池的電極及其製造方法	TW	獲證	98104173	I376049	20121101	20290209	經濟部技術處	
13	P549600 09TWC1	被動式燃料電池系統	TW	獲證	97113609	I357681	20120201	20280414	經濟部技術處	
14	P549700 51CN	質子交換膜與其形成方法	CN	獲證	200810185731.2	101747572	20110727	20281207	經濟部技術處	
	P549700 51JP	質子交換膜與其形成方法	JP	獲證	2009-155885	5028451	20120629	20290629	經濟部技術處	
	P549700 51TW	質子交換膜與其形成方法	TW	獲證	97145902	I384024	20130201	20281126	經濟部技術處	
	P549700 51US	質子交換膜與其形成方法	US	獲證	12/418,534	8,008,360	20110830	20300304	經濟部技術處	
15	P549700 92CN	互穿網狀質子交換膜與其形成方法及質子交換膜燃料電池	CN	獲證	200910149516.1	101931086	20121212	20290624	經濟部技術處	
	P549700 92JP	互穿網狀質子交換膜與其形成方法及質子交換膜燃料電池	JP	獲證	2009-293026	5236623	20130405	20291223	經濟部技術處	
	P549700 92TWC1	互穿網狀質子交換膜與其形成方法及質子交換膜燃料電池	TW	獲證	98130178	I443133	20140701	20290907	經濟部技術處	
	P549700 92US	互穿網狀質子交換膜與其形成方法及質子交換膜燃料電池	US	獲證	12/567,048	8,501,368	20130806	20310911	經濟部技術處	



16	P549800 10CN	改性超支化聚合物、應用其所制成的質子交換膜及其製法	CN	獲證	200910162628.0	101997125	20130710	20290813	經濟部技術處	
	P549800 10TW	改質超分歧高分子、和應用此改質超分歧高分子所製成之質子交換膜及其製法	TW	獲證	98126173	I404751	20130811	20290803	經濟部技術處	
	P549800 10US	改質超分歧高分子、和應用此改質超分歧高分子所製成之質子交換膜及其製法	US	獲證	12/623,642	8,389,639	20130305	20310601	經濟部技術處	
17	P059400 22CN	一種儲能裝置、儲能裝置的封裝結構及其製造方法	CN	獲證	200510132981.6	100505378	20090624	20251230	經濟部技術處	
	P059400 22TW	一種儲能裝置、儲能裝置之封裝結構及其製造方法	TW	獲證	94139777	I270093	20070101	20251110	經濟部技術處	
18	P270000 53CNC1	電容器及其製造方法	CN	獲證	201210239745.4	103165294	20151216	20320709	經濟部技術處	
	P270000 53TWC1	電容器及其製造方法	TW	獲證	101120686	I466153	20141221	20320607	經濟部技術處	
	P270000 53US	電容器及其製造方法	US	獲證	13/615,650	8,848,339	20140930	20330211	經濟部技術處	
19	P270100 09TW	多孔性碳材材料及其製作方法、以及超級電容器	TW	獲證	101140050	I472483	20150211	20321029	經濟部技術處	
	P270100 09US	多孔性碳材材料及其製作方法、以及超級電容器	US	獲證	13/728,700	9,425,000	20160823	20340919	經濟部技術處	
20	P270100 29TW	多孔性碳材材料的製作方法	TW	獲證	101144659	I518718	20160121	20321128	經濟部技術處	
21	P279901 10JP	多孔性碳材材料及其製作方法	JP	獲證	2011-200612	5594694	20140815	20310913	經濟部技術處	
	P279901 10TWC1	多孔性碳材材料及其製作方法	TW	獲證	100120108	I427030	20140221	20310608	經濟部技術處	
22	P540200 41TW	電解質迴流電池	TW	獲證	102148543	I481092	20150411	20331225	經濟部技術處	
23	P540500 39CN	無機粉體製作裝置以及無機粉體製作與分級裝置	CN	獲證	201720191381.5	206652487	20171121	20270228	經濟部技術處	
	P540500 39TW	無機粉體製作裝置以及無機粉體製作與分級裝置	TW	獲證	105219426	M541176	20170501	20261220	經濟部技術處	
24	P549500 66CN	極板導電結構	CN	獲證	200710096447.3	101290983	20120829	20270416	經濟部技術處	
	P549500 66TW	極板導電結構	TW	獲證	95149397	I404256	20130801	20261227	經濟部技術處	曾授權



25	P549500 69CN	電化學元件封裝結構	CN	獲證	200710006244.0	101241977	20110831	20270206	經濟部技術處	
	P549500 69TW	電化學元件封裝結構	TW	獲證	95149997	I371234	20120821	20261228	經濟部技術處	
26	P549700 10CN	儲能組件	CN	獲證	200810189429.4	101764266	20130724	20281223	經濟部技術處	
	P549700 10TW	儲能元件	TW	獲證	97145454	I385844	20130211	20281124	經濟部技術處	
27	P059200 33TW	表面具有垂直氧化鋅奈米線陣列之基材及其製法	TW	獲證	92133942	I242611	20051101	20231201	經濟部技術處	
	P059200 33US	表面具有垂直氧化鋅奈米線陣列之基材及其製法	US	獲證	10/822,648	7,235,129	20070626	20250225	經濟部技術處	
28	P059400 05TW	奈米一維材料之製造方法	TW	獲證	94119803	I282776	20070621	20250614	經濟部技術處	
29	P220000 03US	圖案化層狀材料與形成轉印模的方法	US	獲證	13/609,854	8,540,888	20130924	20320910	經濟部技術處	
30	P540000 20CN	白色無機塗料組合物及包含其所形成的塗層的裝置	CN	獲證	201110369361.X	103044974	20150401	20311117	經濟部技術處	
	P540000 20TW	白色無機塗料組合物及包含其所形成之塗層的裝置	TW	獲證	100136887	I443153	20140701	20311011	經濟部技術處	
31	P540100 03CN	氧化物薄膜的圖案化制程	CN	獲證	201210413839.9	103578922	20160323	20321024	經濟部技術處	
	P540100 03TW	氧化物薄膜的圖案化製程	TW	獲證	101127561	I523073	20160221	20320730	經濟部技術處	
	P540100 03US	氧化物薄膜的圖案化製程	US	獲證	13/942,162	8,906,247	20141209	20330714	經濟部技術處	
32	P540100 10CN	氧化錫膜及其製造方法	CN	獲證	201280076521.4	104736740	20161019	20321227	工研院	
	P540100 10CND1	氧化錫膜及其製造方法	CN	獲證	201610485940.3	105951061	20180713	20321227	工研院	
	P540100 10TW	氧化錫膜及其製造方法	TW	獲證	101151116	I579240	20170421	20321227	工研院	非專屬授權中
33	P540200 15TW	紅外光阻隔之金屬氧化物多層膜結構	TW	獲證	102130002	I487625	20150611	20330821	經濟部技術處	
34	P549900 09AU	紅外光阻隔多層膜結構	AU	獲證	2012201024	2012201024	20140403	20320221	經濟部技術處	
	P549900 09CN	紅外光阻隔多層膜結構	CN	獲證	201010563204.8	102466834	20140430	20301123	經濟部技術處	



	P549900 09DE	多膜層氧化物紅外光反射玻璃	DE	獲證	EP10196789.1	EP2460781	20170906	20301222	經濟部技術處	
	P549900 09FR	多膜層氧化物紅外光反射玻璃	FR	獲證	EP10196789.1	EP2460781	20170906	20301222	經濟部技術處	
	P549900 09IN	紅外光阻隔多層膜結構	IN	獲證	547/MUM/2012	293696	20180301	20320228	經濟部技術處	
	P549900 09MX	紅外光阻隔多層膜結構	MX	獲證	MX/a/2012/003 368	334684	20151105	20320320	經濟部技術處	
	P549900 09MY	紅外光阻隔多層膜結構	MY	獲證	PI2012001058	156786	20160331	20320307	經濟部技術處	
	P549900 09TW	紅外光阻隔多層膜結構	TW	獲證	99138292	I447441	20140801	20301107	經濟部技術處	
	P549900 09US	紅外光阻隔多層膜結構	US	獲證	12/976,897	8,659,822	20140225	20320111	經濟部技術處	
35	0549100 32TW	具有表面奈米機能結構之材料及其製造方法	TW	獲證	91125299	I224079	20041121	20221024	經濟部技術處	
其他 應用	36	P029400 51TW	矽酮化合物及其用途	TW	獲證	94146615	I323735	20100421	20251226	經濟部技術處
	37	P059200 70TW	共振感測器與其製作方法	TW	獲證	92137619	I232291	20050511	20231230	經濟部技術處
	38	P059200 74TW	可調變高壓反應裝置	TW	獲證	93106135	I237748	20050811	20240308	經濟部技術處
	39	P540000 85CN	雙光軸相位差膜及其製造方法	CN	獲證	201110449816.9	103163686	20160120	20311228	經濟部技術處
		P540000 85TW	雙光軸相位差膜及其製造方法	TW	獲證	100146118	I453509	20140921	20311213	經濟部技術處
		P540000 85US	雙光軸相位差膜及其製造方法	US	獲證	13/491,369	8,736,797	20140527	20320716	經濟部技術處
	40	P549500 71TW	顯色材料及其製法	TW	獲證	95149473	I343402	20110611	20261227	經濟部技術處
	41	P549700 41JP	氣體感測器	JP	獲證	2009-054100	4927115	20120217	20290305	經濟部技術處
		P549700 41TW	氣體感測器	TW	獲證	97146681	I374265	20121011	20281130	經濟部技術處
	42	P549700 57CNC1	相位差膜與其形成方法	CN	獲證	200910150471. X	101726785	20111026	20290622	經濟部技術處



	P549700 57TWC1	相位差膜與其形成方法	TW	獲證	98118148	I395024	20130501	20290601	經濟部技術處	
	P549700 57US	相位差膜與其形成方法	US	獲證	12/496,547	8,257,800	20120904	20310324	經濟部技術處	
43	P549700 58TW	碟型含銀化合物及其應用	TW	獲證	97151844	I385154	20130211	20281230	經濟部技術處	
44	P549700 67CNC1	陶瓷基板及其製造方法	CN	獲證	201010110451.2	101928156	20121121	20300202	經濟部技術處	
	P549700 67TWC1	陶瓷基板及其製造方法	TW	獲證	98141302	I467706	20150101	20291202	經濟部技術處	
	P549700 67US	陶瓷基板及其製造方法	US	獲證	12/691,728	8,343,617	20130101	20310225	經濟部技術處	
45	P549800 73TW	生質型化學碳粉組成物及其製備方法	TW	獲證	98143079	I400587	20130701	20291215	經濟部技術處	
	P549800 73US	生質型化學碳粉組成物及其製備方法	US	獲證	12/729,200	8,283,099	20121009	20310125	經濟部技術處	

備註: 本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外, 包含上開專利之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利、PCT 同一案所申請之各國專利。